遮熱コーティングの熱酸化検出におけるトップコート膜厚補正法 Topcoat thickness correction in detection of thermal oxidation of thermal

autifier coating 福地哲生,江藤修三,岡田満利,藤井智晴 電力中央研究所 T. Fukuchi, S. Eto, M. Okada, T. Fujii Central Research Institute of Electric Power Industry

Abstract The thermally grown oxide (TGO) layer forms below the topcoat of thermal barrier coating (TBC) and is an important factor which causes topcoat delamination. The TGO layer can be detected using laser-induced photoluminescence (PL). Since the laser light and PL must transmit through the topcoat, the PL signal must be corrected for the topcoat thickness. In this report, the topcoat attenuation coefficient α was measured by comparing the PL intensities from the TGO layer in the presence and absence of the topcoat, which resulted in α =7.3 mm⁻¹. The topcoat thickness of TBC samples were measured using terahertz reflectometry. When the PL signals from TBC samples were corrected using the measured values of α and the topcoat thickness, the correlation between the PL intensity and heating time was improved.

1. はじめに

ガスタービン火力発電設備において、ガスタービン翼や燃焼器などの高温部品には合金製である 基材を保護するために遮熱コーティング(TBC: thermal barrier coating)が施されている。TBC は Fig.1 に示すように、セラミックス製のトップコート(TC: topcoat)と合金製のボンドコート(BC: bondcoat) から成り、Ni 基合金製の基材上にプラズマ溶射で施工される。TC にはイットリア部分安定化ジル コニア、BC には NiCrAIY 合金(又は CoCrAIY, NiCoCrAIY)が一般的に用いられている。TC 表 面が接する燃焼ガス温度は 1000℃を超えるが、TBC の遮熱効果と基材の内部冷却によって、基材 温度は機械的に安全な温度に保たれる。TC の厚さは 200~600µm、BC の厚さは 100~200µm であ り、近年においては熱効率向上のための入口温度の高温化に伴い TC の厚膜化が進んでいる。

TC 剥離は経年使用による TBC の主たる損傷劣化であり, TC 剥離に大きな影響を与える要因と して, TC と BC 間の界面に形成される熱酸化物(TGO: thermally grown oxide)の層(以下, 界面酸 化層)が挙げられる。TC 剥離検査には赤外線加熱とサーモグラフィの組み合わせが通常用いられ るが,検査時間がかかる。TC 剥離の可能性が高い箇所には TGO が存在することが多いことから, 剥離検査を TGO 検出箇所に限定すれば剥離検査の効率化が図れる。

2. 光ルミネッセンス法の概要

界面酸化層は BC を構成する元素の酸化物から成り, BC 構成元素の中で Al は最も酸化しやすいため, 界面酸化層は Al₂O₃ を多く含む。Cr は Cr³⁺として Al₂O₃ 中に混在するため, 界面酸化層は Cr³⁺:Al₂O₃ に似た光学的性質を示す。Cr³⁺:Al₂O₃ のエネルギー準位図を Fig.2 に示す。



Fig. 1 Schematic diagram of TBC (thermal barrier coating) and topcoat delamination following formation of the TGO (thermally grown oxide) layer



 Al_2O_3 中の Cr^{3+} が青色または緑色の光を吸収すると,基底準位 ${}^{4}A_2$ から ${}^{4}F_1$ または ${}^{4}F_2$ へ励起され, 内部エネルギー緩和を経て²Eへ遷移する。²Eの放射寿命は 3ms であり,赤色の光(R₁線: 694.3nm, R₂線: 692.9nm)を放射して⁴A₂へ緩和する。光ルミネッセンス(PL: photoluminescence)法はこの 性質を利用して界面酸化層中の Cr³⁺を検出する。界面酸化層が存在しない場合, Cr は合金を形成す る状態にあり,発光しない。これまでに,パルスレーザを用いて界面酸化層中の Cr³⁺の放射寿命な どを評価し^[1,2],連続発振レーザを適用して励起光源の小型化を図った^[3,4]。

PL 法では、励起光(レーザ光)と Cr³⁺の発光が TC を透過する必要があるため、測定される PL 強度は TC の厚さに依存する。TC 厚さは部位によって異なるため、界面酸化層中の Cr³⁺の総数に対 応する信号強度を得るには、TC 厚さに対する補正が必要である。補正を行うには、TC 中の励起光 と発光の減衰係数、および TC 厚さを測定する必要がある。

3. 減衰係数測定

TC 中の減衰係数を測定するために,直径 25mm,厚さ 3mmの基板上に厚さ約 100µmの BC と厚 さ約 300um の TC を施工した TBC 試験体を用いた。界面酸化層を形成するために、TBC 試験体を 1100℃において 1000hr 加熱した。その後, TC と BC の界面に応力を加えた結果, 界面酸化層を境 に TC が剥落し, TC 側と基板側に分割された。界面酸化層は TC 側の裏側,基板側の表側の双方に 付着している。

測定実験構成を Fig.3 に示す。Nd:YAG レーザ (HC Photonics 社製, GLMP-0200A, 波長 532nm, cw, 最大出力 200mW) からの光を拡げ, ビーム径が 25mm となる位置に TBC 試験体を設置した。 カットオフ波長 600nm のロングパスフィルタで TC 表面からのレーザ反射光を除去し, 光ファイバ を介して分光器 (Acton 社製, Spectra-Pro 2300i) および ICCD カメラ (Roper Scientific 社製, PI-MAX 1k) で PL 測定を行った。露光時間は 20 秒間(積算時間 2 秒×10 回平均)とし、ゲインは使用し なかった。

減衰係数を得るために、界面酸化層が露出した基板側の PL 測定(Fig.4 の配置 A)を行った後、 界面酸化層が露出していない TC 側表面の測定(Fig.4 の配置 B)を行った。レーザ波長をん, PL 波長を λ_L とした場合,配置 A で測定される光強度 $L_4(\lambda_L)$ は式(1),配置 B において測定される光強度 $I_B(\lambda_L)$ は式(2)で与えられる。ここで $I_0(\lambda_0)$ は入射光強度, N は単位面積あたりの Cr^{3+} の数, $\sigma(\lambda_0)$ は Cr^{3+} の吸収断面積、 η は ⁴F→²Eの遷移割合、 $C(\lambda_l)$ は光ファイバの集光率・ロングパスフィルタと光ファ イバの透過率・分光器の量子効率などを含む受光効率,T(A)およびT(A)はそれぞれ波長A および *λ*における TC の透過率である。

 $I_{A}(\lambda_{L}) = I_{0}(\lambda_{0})N\sigma(\lambda_{0})\eta C(\lambda_{L})$ (1)

 $I_B(\lambda_L) = I_0(\lambda_0) T(\lambda_0) N \sigma(\lambda_0) \eta T(\lambda_L) C(\lambda_L) \dots (2)$

配置 A, B における測定条件は同一であるため装置に起因する因子 I₀, C は不変である。また,同 じ界面酸化層を対象としているため N は不変である。 η , σ は Cr³⁺の物理的性質であり,実験条件に 依存しない。よって、式(1)と式(2)の比から TC の透過率が求まる。

 $T(\lambda_0)T(\lambda_L) = I_B(\lambda_L) / I_A(\lambda_L)$ (3)





measurement of TBC specimen



TC 厚さ*d*,減衰係数*a*,往復の透過率*T*_{*t*}は*T*_{*t*}=*T*(λ_0)*T*(λ_L)exp[-($\alpha_0 + \alpha_L$)*d*]の関係にある。ここで α_0 は λ_0 =532 nm, α_L は λ_L =694nm における減衰係数である。TC の減衰係数 α をこれらの平均値とすると, α は式(3)から求まる。

$$\alpha = -\frac{\ln(T_t)}{2d} = -\frac{1}{2d} \ln \left| \frac{I_B(\lambda_L)}{I_A(\lambda_L)} \right|$$

配置 A, B で得られた PL のスペクトルを Fig.5 に示す。配置 A における PL は配置 B に おける PL よりも極めて強いため(TC による 減衰が存在しないため),Fig.5 では配置 A に おいて ND フィルタで PL 強度を 1%に減衰さ せた場合のスペクトルを示した。配置 A, B におけるスペクトルの極大値の比は 0.0127, 波長 690~698nm における積分値の比は 0.0125 であった。透過率を T_i =0.0126とすると, 式(4)から α =7.3mm⁻¹となる。

TC 材料であるイットリア安定化ジルコニ アの可視域における吸収係数は約 10mm⁻¹で あることが報告されている^[5]。しかし,これ は結晶体を対象とした場合であり、プラズマ 溶射された TC は空孔を含むことから、減衰 係数はこの値よりも低くなることが予想され、 上記の値α=7.3mm⁻¹は妥当と考えられる。



Fig. 5 Luminescence spectra of Cr^{3+} in configurations A and B shown in Fig. 4 (the spectrum for configuration A was measured by attenuating the laser light and photoluminescence with a ND filter)

4. TC 膜厚補正法

同一の界面酸化層(単位面積あたりの Cr³⁺の数 N が同じ界面酸化層)が形成された場合, TC が 膜厚が大きいほど TC 中の減衰が大きく, 測定される PL 強度は小さくなる。ガスタービン翼など に施工されている TBC の TC 膜厚は部位によって異なるため,界面酸化層の形成状況を把握する(N に比例する値を得る)には TC 膜厚に対する補正を行う必要がある。

式(2)および式(4)から, PL 強度の TC 膜厚 d に対する依存性は式(5)となり,これの差分から, TC 厚さ変化 *Ad* (*Ad*<<*d*) に対する PL 強度の相対変化 *Al*/*l* は式(6)で表される。

 $I(\lambda_L) = I_0(\lambda_0) N \sigma(\lambda_0) \eta C(\lambda_L) e^{-2\alpha d}$ (5)

 $\Delta I(\lambda_L) / I(\lambda_L) = -2\alpha \Delta d \tag{6}$

TCの減衰係数を α =7.3mm⁻¹とすると、例えば TC 膜厚が Δd =10 μ m 増すと、PL 強度は 15%減少する。

TC 膜厚に対する補正を行うには、基準 TC 膜厚値 $d^{(0)}$ を決める。次に、部位 *j* における TC 膜厚 d_j を他の手段で測定し、同時に PL 測定を行う。部位 *j* で得られた PL 強度 I_j を式(7)に基づき、 $d^{(0)}$ に相当する強度 $I^{(0)}_j$ に変換する。ここで、 $I^{(0)}_j$ は部位 *j* の TC 膜厚が $d^{(0)}$ であったと仮定した場合の PL 強度に相当する。

 $I_i^{(0)}(\lambda_L) = I_i(\lambda_L) \exp[2\alpha(d_j - d^{(0)})] \dots$ (7)

5. TC 膜厚補正結果

ー例として,温度 1100℃において 200hr, 1000hr 加熱した TBC 試験体,および加熱しなかった試 験体からの PL 強度の測定結果を TC 膜厚に対して補正した。個々の TBC 試験体の TC 膜厚測定に はテラヘルツ(THz: terahertz) 波を用いた。

THz 波イメージング装置 (Picometrix 社製, T-Ray 4000,周波数帯域約 0.1~約 1.2THz)を用いて SUS 板および各 TBC 試験体からの反射波形を測定した結果を Fig.6 に示す。SUS 板は完全導体と見 なせるため (反射係数 r=-1),反射波形は入射波形を反転させたものに相当する。ここで S は TC 表面, R1 は TC 裏面からの反射波, R2 は TC 中を 2 往復する多重反射波であり,時間軸は S の到 達時間が t=0 となるように調整した。S と R1 の時間差 Δt は THz 波が TC 中を 1 往復する (距離 2d を伝搬する)時間に相当することから, TC 膜厚 $d=c\Delta t/2n$ が得られる。ここで n は THz 帯における

TC の屈折率で, *n*=4.8 である^[6]。なお,加熱時間 1000hr の TBC 試験体は上記 3.の減衰係数測定に 用いたもの(TC 側)であり,TC の裏面が TC と空気の界面となっている。他の TBC 試験体の TC の裏面は TC と合金の界面となっているため,反射係数の符号が異なり,その結果 R1 の極性が逆 になっている。

各 TBC 試験体からの反射波 S と R1 の時間差 Δt ,加熱しなかった TBC 試験体の TC 膜厚値 $d^{(0)}$ に 対する TC の相対膜厚値 $d - d^{(0)}$,および PL 強度の補正係数を $y = \exp[2\alpha(d - d^{(0)})]$ を Table 1 に示す。こ こで、 $\alpha = 7.3$ mm⁻¹ とした。式(7)から、y は TC 膜厚が $d^{(0)}$ であった場合の PL 強度 $I^{(0)}$ を求める際に、 測定した強度 I に乗算する係数である。例えば、加熱時間 200hr の TBC 試験体の TC 膜厚は加熱し なかった TBC 試験体よりも大きく、見かけの PL 強度が低くなるが、1.28 倍することで補正できる。

各 TBC 試験体からの PL 強度の測定結果,および TC 膜厚補正を行った結果を Fig.7 に示す。補 正の結果,加熱時間と PL 強度の関係は線形により近い形となった。界面酸化層の成長速度が一定 であれば, Cr³⁺の総数は加熱時間に比例して増加するため,線形性は妥当であると考えられる(界 面酸化層の成長はいずれ飽和するが,加熱温度 1100℃においては加熱時間 1000hr において飽和に 達していないと思われる)。

Table 1 Correction factor of TBC specimens			
heating time	time difference Δt	relative thickness d - $d^{(0)}$	correction factor
[hr]	[ps]	[µm]	$y = \exp[2\alpha(d - d^{(0)})]$
0	10.78	0	1.00
200	11.33	17	1.28
1000	10.70	-2.5	0.96

25



no correction after correction i 15 i 10 i 200 i

Fig. 6 Waveforms of terahertz waves reflected from SUS plate, unheated TBC specimen, and TBC specimens heated at 1100^oC for 200, 1000 hr (S: surface reflection, R1: backside reflection, R2: multiple reflection)

Fig. 7 Photoluminescence intensity from unheated TBC specimen and TBC specimens heated at 1100° C for 0, 200, 1000 hr, showing result before and after topcoat thickness correction

6. おわりに

光ルミネッセンス (PL) 法による遮熱コーティング (TBC) の界面酸化層検出におけるトップコート (TC) 膜厚補正法を考案した。同一の界面酸化層に厚さ 300μm の TC がある場合とない場合 の PL 強度を比較することによって, TC の減衰係数α=7.3mm⁻¹を得た。この値およびテラヘルツ波 を用いて測定した TC の膜厚値に基づき, 1100℃において加熱した TBC 試験体からの PL 強度を補 正した結果, PL 強度と加熱時間の関係はより線形性に近い形となった。

参考文献

- ^[1]福地,他:電気学会論文誌 A, Vol. 133, No. 7, pp. 402-407 (2013)
- ^[2]福地,他:第30回レーザセンシングシンポジウム予稿集,PE-6, pp. 88-89 (2012)
- ^[3]福地,他:電気学会論文誌 A, Vol. 133, No. 11, pp. 565-571 (2013)
- ^[4]福地,他:第31回レーザセンシングシンポジウム予稿集,C-4,pp. 30-31 (2013)
- ^[5] D. Wright et al: Journal of Material Science, Vol. 8, pp. 876-882 (1973)
- ^[6]福地,他:電気学会論文誌 A, Vol. 132, No. 2, pp. 166-172 (2012)